ВЛИЯНИЕ БЕСПОРЯДКА НА ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЩЕЛЕВЫХ ГРАФЕНОВЫХ СВЕРХРЕШЕТОК

Е.С. Азарова, Г.М. Максимова

кафедра теоретической физики ННГУ им. Н.И. Лобачевского

XIV Школа-конференция молодых ученых «Проблемы физики твердого тела и высоких давлений», 2015

Графен



-подвижность носителей

$$E = \pm \upsilon_F |\vec{p}|, \quad \upsilon_F \approx 10^8 \, c_M / c$$
$$\hat{H} \, \psi(x, y) = E \, \psi(x, y), \quad \hat{H} = \upsilon_F \left(\sigma_x \hat{p}_x + \sigma_y \hat{p}_y\right)$$



Сверхрешетка на основе графена



СР: модулированная энергетическая щель + внешний эл./ст. потенциал (теория): G.M.Maksimova, E.S.Azarova, A.V.Telezhnikov, V.A.Burdov, Phys. Rev. B **86**, 205422 (2012). E.S.Azarova, G.M.Maksimova, Physica E **61**, 118 (2014). E.S.Azarova, G.M.Maksimova, Physica E **74**, 1 (2015).



Неупорядоченная мультибарьерная структура

Энергетический беспорядок: $u_i = v(1 + \rho_i^v), \ \Delta_i = \Delta(1 + \rho_i^{\Delta})$ Позиционный беспорядок: $a_i = a(1 + \rho_i^a), \ d_i = d(1 + \rho_i^d)$ $u_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad u_1 \quad u_2 \quad u_3 \quad u$

3/9

Длина локализации

$L_{loc} = l / \gamma - \partial$ лина локализации

 $\left| \gamma = -\lim_{N \to \infty} \left\langle \frac{\ln T_N}{2N} \right\rangle - nоказатель Ляпунова (обратная длина локализации)$

 $T = |t|^2 = |\hat{M}_{22}|^{-2} - \kappa o \Rightarrow \phi \phi$ ициент прохождения через систему

 $\hat{M} = \prod S_i$ — матрица переноса

Разложение трансфер – матрицы:

 $S_i = S + \varepsilon_i S' + \frac{\varepsilon_i^2}{2} S'' + O(\varepsilon_i^3)$ (Q. Zhao, J. Gong, Phys. Rev. B **85**, 104201 (2012).)

$$\gamma_s = \frac{s^2 \sigma_s^2}{2} \tan^2 \varphi \left[p'^2 + \left(\frac{\sin m}{\sin \varphi} \right)'^2 \frac{\tan^2 \varphi}{\sin^2 \eta} \right] - paspecience 30 Hz$$

bl $\sigma_s^2 \ll 1$

 $\cos \eta = \cos \alpha \cos \beta + f \sin \alpha \sin \beta - \partial u cnep cuohhoe ypabhehue,$

$$f = \frac{\varepsilon \upsilon - k_x^2}{k_x q_x}, \ \alpha = k_x a, \ \beta = q_x d$$

 $\gamma_s = \ln \lambda_+$ – запрещенные зоны

E.S. Azarova, G.M. Maksimova, Physica E 74, 1 (2015).





Энергетический беспорядок

Флуктуации <u>внешнего потенциала</u>: $\sigma_{\nu}^{2} = \delta^{2}/3$ $\gamma_{\upsilon}^{MSL} = \frac{\upsilon^2 \sigma_{\upsilon}^2}{2q_x^2} \left[\frac{k_y^2 \Delta^2 \sin^2 \beta}{S} + \frac{S(F^M \sin \alpha + G^M \cos \alpha)^2}{k_x^2 q_x^2 \sin^2 \eta} \right] - HCP$ $\gamma_{\nu}^{HSL} = \frac{\nu^2 \sigma_{\nu}^2 (k_{\nu}^2 + \Delta^2)}{2k_x^2 q_x^2 \sin^2 \eta} \left(F^H \sin \alpha + G^H \cos \alpha \right)^2 - OCP$ HCP: OCP: χ², 10⁴ 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 3.5 4.0 4.5 $\gamma_{\nu}, 10^{-3}$ $\gamma_{\nu}, 10^{-3}$ 1 % 1 % 10 10 2 4 6 4 6 8 $\gamma_{\nu},\,10^{-3}$ $\gamma_{\nu}, 10^{-2}$ 2 50 % 50 % 10 2 4 6 8 2 4 6 8 10 ε ε

Параметры : $N = 5 \cdot 10^3$ $\theta_0 = 0 - HCP$ $\theta_0 = \pi / 6 - OCP$ a = d = 0.5 $\upsilon = \pi$ $\Delta = \pi / 3$ n = 80

7/9



8/9

Выводы:

- Получено аналитическое выражение для обратной длины локализации (показателя Ляпунова) для щелевых графеновых сверхрешеток в приближении слабого беспорядка.
- 2. Делокализационные резонансы, связанные с флуктуациями ширины барьера (межбарьерной области) устойчивы к возрастанию степени беспорядка.
- 3. Основной эффект корреляций, который заключается в изменении длины локализации, проявляется вблизи двойных резонансов.
- 4. Делокализационные резонансы, обусловленные энергетическим беспорядком, являются приближенными в отличие от резонансов Фабри-Перо.
- 5. Для массивных дираковских частиц (однородная сверхрешетка) в случае флуктуаций высоты барьеров резонансные условия могут быть выполнены при произвольных углах падения, в то время как в структурах с неоднородной щелью делокализация возможна только для нормально падающих частиц.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



приложение

References:

[1] C.-H. Park, L.Yang, Y.-W.Son, M.L.Cohen, S.G.Louie, Nat. Phys. 4(2008)213. [2] L. Brey, H.A. Fertig, Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 046809. [3] M. Barbier, P. Vasilopoulos, F.M. Peeters, Phys. Rev. B81(2010)075438. [4] L. Dell'Anna, A. DeMartino, Phys. Rev. B79(2009)045420. [5] V.Q. Le,C.H.Pham,V.L.Nguyen,J.Phys.Condens.Matter24(2012)345502. [6] D.P.Arovas, L.Brey, H.A.Fertig, E.-A.Kim, K.Zeigler, New J.Phys. 12(2010) 123020. [7] M. Esmailpour, et. al, SolidStateCommun. 150(2010)655. [8] S. Dubey, et.al., NanoLett. 13(2013)3990. [9] Li-Gong Wang, XiChen, J. Appl. Phys. 109 (2011) 033710. [10] Y.-W.Son, M.L.Cohen, S.G.Louie, Phys. Rev. Lett. 97(2006)216803. [11] M.Y.Han, B.Özyilmaz, Y.Zhang, P.Kim, Phys. Rev. Lett. 98(2007)206805. [12] Q. Yan et. al., Nano Lett. 7(2007)1469. [13] W.Apel, G.Pal, L.Schweitzer, Phys. Rev. B83(2011)125431. [14] G. Gui, J.Li, J.Zhong, Phys. Rev. B78(2008)075435. [15] V.M. Pereira, A.H. Castro Neto, N.M.R. Peres, Phys. Rev. B80(2009)045401. [16] R.M. Ribeiro, N.M.R.Peres, J.Coutinho, P.R.Briddon, Phys. Rev. B78(2008) 075442. [17] G. Giovanetti et. al., Phys. Rev. B 76(2007)073103. [18] S.Y.Zhou, et.al., Nat. Mater. 6(2007)770. [19] Di Xiao, Gui-BinLiu, W.Feng, X.Xu, Wang Yao, Phys. Rev. Lett. 108(2012) 196802. [20] Xiao Li, FanZhang, QianNiu, Phys. Rev. Lett. 110 (2013) 066803. [21] N.M.R. Peres, J.Phys.Condens.Matter21(2009)095501. [22] Viana Gomes, N.M.R.Peres, J.Phys.Condens.Matter20(2008)325221. [23] G. Giavaras, F. Nori, Appl. Phys. Lett. 97(2010)243106.

[24] P.V.Ratnikov, A.P.Silin, Phys.SolidState52(2010)1763. [25] G.M. Maksimova et.al., Phys. Rev. B86 (2012)205422. [26] E.S. Azarova, G.M. Maksimova, PhysicaE61(2014)118. [27] H.A. Fertig, L.Brey, Phys. Trans. R.Soc. 368(2010)5483. [28] K. Nomura, M. Koshino, S. Ruy, Phys. Rev. Lett. 99(2007)146806. [29] Shi-Liang Zhu, Dan-WelZhang, Z.D. Wang, Phys. Rev. Lett. 102(2009)210403. [30] Yu.P.Bliokh, V.Freilikher, S.Savel'ev, F.Nori, Phys. Rev. B79 (2009)075123. [31] N. Abedpour, A. Esmailpour, R. Asgari, M. Reza, R. Tabar, Phys. Rev. B 79(2009)165412. [32] Qifang Zhao, JiangbinGong, CordA. Müller, Phys. Rev. B85(2012)104201. [33] AyoubEsmailpour, FatemehPakdel, RaziehJahanaray, PhysicaE54(2013)214. [34] P.Marcoš, CostasM.Soukoulis, PrincetonUniversityPress, Princeton, 2008. [35] M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov, A.K. Geim, Nat. Phys. 2(2006)620. [36] J. MiltonPereiraJr., P.Vasilopoulos, F.M.Peeters, Appl. Phys. Lett. 90(2007) 132122. [37] A.V.Shytov, M.S.Rudner, L.S.Levitov, Phys.Rev.Lett.101(2008)156804. [38] M. RamezaniMasir, P. Vasilopoulos, F.M. Peeters, Phys. Rev. B82(2010) 115417. [39] G.A. Luna-Acosta et.al., Phys. Rev. B80(2009)115112. [40] D. Mogilevtsev et.al., Phys.Rev.B84(2011)094204.

Волновой вектор

$$\alpha = k_x a, \ \beta = q_x d$$

HCP	OCP
$k = \varepsilon , \ k_x = \varepsilon \cos \theta_0$	$k = \sqrt{\varepsilon^2 - \Delta^2}, \ k_x = \sqrt{\varepsilon^2 - \Delta^2} \cos \theta_0$
$q=\sqrt{(\varepsilon-\upsilon)^2-\Delta^2},$	$q = \sqrt{(\varepsilon - \upsilon)^2 - \varepsilon^2 + \Delta^2},$
$q_x = \sqrt{\left(\varepsilon - \upsilon\right)^2 - \Delta^2 - \varepsilon^2 \sin^2 \theta_0}$	$q_x = \sqrt{(\varepsilon - \upsilon)^2 - \Delta^2 - (\varepsilon^2 - \Delta^2) \sin^2 \theta_0}$

Спектр ГСР с периодически модулированной щелью

$$E_0 = \frac{V^2 - \Delta^2}{2V} \qquad k_{yn} = \frac{1}{l} \sqrt{\left(\frac{E_0 l}{\hbar \upsilon_F}\right)^2 - (2\pi n)^2} \qquad V_n = \frac{\pi n \hbar \upsilon_F}{d} + \sqrt{\left(\frac{\pi n \hbar \upsilon_F}{d}\right)^2 + \Delta^2}$$



G.M. Maksimova, E.S. Azarova, A.V. Telezhnikov, V.A. Burdov, Phys. Rev. B 86, 205422 (2012)

Коэффициент прозрачности однобарьерной структуры



 $\Delta = 0, V \neq 0$:M.I. Katsnelson, K.S. Novoselov, A.K. Geim, Nat. Phys. 2 620 (2006). $\Delta \neq 0, V = 0$:J.V. Gomes, N.M.R. Peres, J. Phys.: Condens. Matter 20 325221 (2008). $\Delta \neq 0, V \neq 0$:E.S. Azarova, G.M. Maksimova, Physica E 61, 118 (2014).

Рассеяние дираковских частиц двухбарьерным потенциалом



Рис. 17. Коэффициент прохождения квазичастиц через два потенциальных барьера при *a* = *d* = 30 *nm*.

E.S. Azarova, G.M. Maksimova, Physica E 61, 118 (2014)

Энергетическая щель

Материал	<i>Е</i> _{<i>g</i>} , эВ
Графен	0
Si	1.12
Ge	0.67
GaAs	1.42

Подвижность носителей

Материал	<i>µ,</i> см²/(В⋅с)
Графен	2·10 ⁵
Si	1400
Ge	3900
GaAs	8500

Удельное сопротивление

Материал	<i>р,</i> Ом/см
Графен	1.10-6
Ag	1.5 . 10-6
Cu	1.7 . 10-6

Коэффициент теплопроводности

Материал	λ, Вт/(м·К)
Графен	5000
Ag	430
Cu	400
AI	210

Прочность и упругость

Материал	<i>Е,</i> Па
<u>Графен</u>	1 · 10 ¹²
Ir	520 · 10 ⁹
W	350 · 10 ⁹
Cr	300 · 10 ⁹